

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(10) Numéro de publication internationale
WO 2024/110364 A1

(43) Date de la publication internationale
30 mai 2024 (30.05.2024)

WIPO | PCT

(51) Classification internationale des brevets :

H01L 21/762 (2006.01) H01L 21/20 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/EP2023/082341

(22) Date de dépôt international :

20 novembre 2023 (20.11.2023)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

FR2212220 23 novembre 2022 (23.11.2022) FR

(71) Déposant : COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
[FR/FR] ; 25 RUE LEBLANC, BAT LE PONANT, 75015
PARIS (FR).

(72) Inventeurs : LAURANT, Christine ; 17 Avenue des Mar-
tyrs, 38054 GRENOBLE Cedex 09 (FR). AUGENDRE,
Emmanuel ; 17 Avenue des Martyrs, 38054 GRENOBLE
Cedex 09 (FR).

(74) Mandataire : HAUTIER IP ; 20 Rue de la Liberté, 06000
Nice (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) :

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection régionale disponible) :

ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING A STACK COMPRISING AN INSULATING LAYER

(54) Titre : PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN EMPILEMENT COMPRENANT UNE COUCHE ISOLANTE

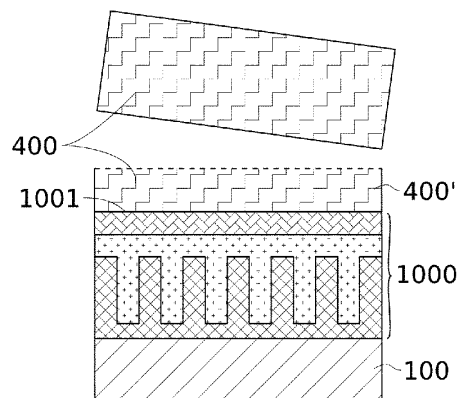


FIG. 6C

(57) Abstract: The invention relates to a method for manufacturing a stack, which includes providing an initial stack having a base substrate based on a first material and a first insulating layer having an array of walls made of a first insulating material separated by trenches, filling the trenches with a second insulating material, thereby forming a second insulating layer, and forming a semiconductor film on the second insulating layer.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'un empilement comprenant la fourniture d'un empilement initial comprenant un substrat socle à base d'un premier matériau et une première couche isolante comprenant un réseau de murs constitués d'un premier matériau isolant séparés par des tranchées, le remplissage des tranchées par un deuxième matériau isolant, formant ainsi une deuxième couche isolante, et la formation d'un film semiconducteur sur la deuxième couche isolante.

[Suite sur la page suivante]



WO 2024/110364 A1

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))
- en noir et blanc ; la demande internationale telle que déposée était en couleur ou en échelle de gris et est disponible sur PATENTSCOPE pour téléchargement.